ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА



В. АНДРЕЕВ

На адресные входы ИМС ППЗУ подается код адреса, а на выходы — записываемая информация, в соответствии с которыми выбираются те запоминающие элементы, которые будут подвергнуты программированию. На управляющие входы ИМС поступают электрические импульсы определенной амплитуды и длительности, которые воздействуют на запоминающий элемент и вызывают в нем физические или структурные изменения. В результате при чтении запоминающий элемент будет выдавать на выход инверсную

информацию по сравнению с незапрограммированным состоянием (см. временную диаграмму).

Некоторые микросхемы ППЗУ имеют несколько управляющих входов CS. В этом случае управление работой ИМС осуществляется подачей комбинаций сигналов на все входы CS (см. табл.).

Основные электрические параметры однократно программируемых микросхем приведены в таблице.

ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ МИКРОСХЕМ ППЗУ

Тип	Режим работы													
микросхемы	Хранение				Чтение				Программиро- вание					
	CS4	CS3	CS2	CS1	CS4	CS3	CS2	CS1	CS4	CS3	CS2	CS1		
KP556PT4, KP556PT4A, KP556PT11		-	1	1	-		0	0	-	-	0	1		
KP556PT5, KP556PT17	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1		
KP556PT12, KP556PT13	-	-	1	1	3 -	-	0	0	-	-	1	0		
KP556PT14, KP556PT15	1-1	_x	-	1	-	-	-	0	-	-	-	1		
KP556PT16	-	-	-	1	-	-	-	0	-		-	1		
KP556PT17, KP556PT18	- S	1	11	1 heart	=	1	1	0	-	1	1	1		

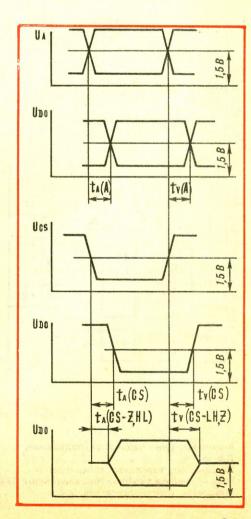


ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИМС ППЗУ

	Инфор- мац. емк., бит	Орга- низа- ция ПЗУ, слов × × разря- дов	Статические параметры в режиме считывания							Динамические параметры в режиме считывания				Исх.	100000000000000000000000000000000000000	W. C.	- Корп.
БИС			I _{cc max} , MA	U _{Bx. max} , B	I ⁰ _{Bx. max} , MA	U ¹ вых. min, В	I ¹ _{вых. min} , мкА	I ⁰ вых. max, мА	Фп	t _{A(A)} , HC	t _{A(C\$)} ,	t _{V(A)} , HC	t _{V(CS)} ,	сост.	вы- хо- да	зн.	
KP556PT17 KP556PT12 KP556PT13 KP556PT14 KP556PT15 KP556PT7A KP556PT78 KP556PT18	8192 8192	518×8 1024×4 1024×4 2048×4 2048×4 2048×8 2048×8 8192×8	175 140 140 140 140 185 180 190	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	2,4 2,4 2,4 2,4 2,4	100 100 100 100 100 100 100 100	15 16 16 16 16 85 15	- - - 100	50 60 60 60 60 80 60 85	30 45 45 45 45 40 40 40	50 60 60 60 60 80 60 85	30 45 45 45 45 40 40 40	1 0 0 0 0 0	TC OK TC OK TC OK TC	5 6 7 8 9 10 11 12	

ПРИМЕЧАНИЕ.

Технология - ТТЛШ.

Напряжение питания - Ucc=4,75-5,25 В.

Входное напряжение высокого уровня: U_{вх. max}=4,5 В, U_{вх. min}=2,4 В.

Входное напряжение низкого уровня: $U_{Bx, max}^0 = 0,5 \text{ B}, U_{Bx, min}^0 = 0 \text{ B}.$

Входной ток логической $1 - I_{Bx. min}^{1} = 40$ мкА.

Входной ток логического $0 - I_{Bx, max}^0 = 0,25$ мА.

Выходное напряжение логического 0 — U_{вых. мах}=0,5 В.

Интервал рабочих температур: -10...+70°С.

В ТАБЛИЦЕ ПРИМЕНЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 $I_{\rm cc}$ — ток потребления, $U_{\rm bx}^0$ — входное напряжение логического 0,

10° — входной ток логического 0, 10 м — выходной ток логического 0,

U_{вых} — выходное напряжение логической 1,

 $I_{\text{вых}}^1$ — выходной ток логической 1,

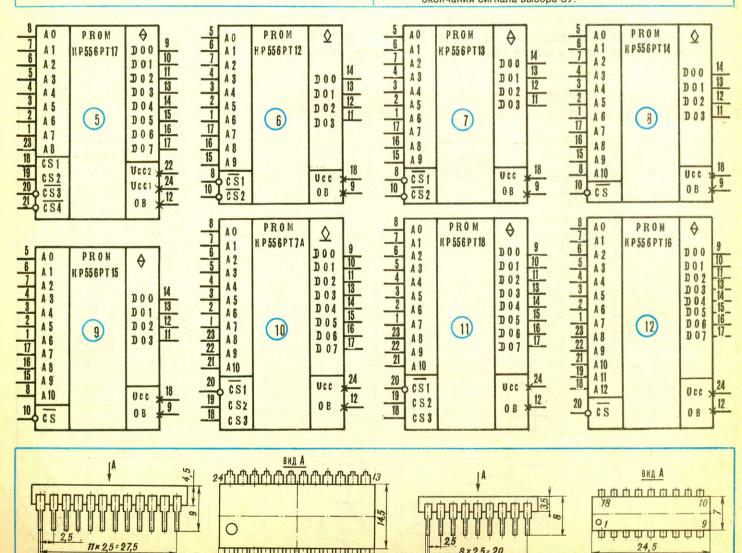
С_{L тах} - емкость нагрузки,

t_{A(A)} — время выборки адреса,

t_{V(A)} — время сохранения выходной информации после сигнала адреса.

t_{A(CS)} - время выборки сигнала выбора ЗУ,

t_{V(CS)} - время сохранения сигнала выходной информации после окончания сигнала выбора ЗУ.



H